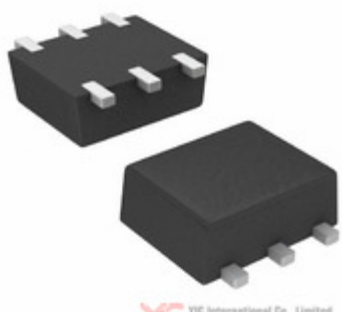

	<p>Hersteller-Teilenummer: SI1058X-T1-E3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 1.3A SOT563F</p>
	<p>Datenblätter:  SI1058X-T1-E3.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>


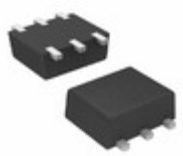
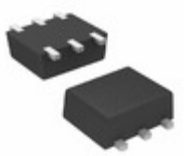



Spezifikationen

Teilenummer	SI1058X-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 1.3A SOT563F
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.55V @ 250µA
Vgs (Max)	±12V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	SC-89-6
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	91 mOhm @ 1.3A, 4.5V
Verlustleistung (max)	236mW (Ta)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	SOT-563, SOT-666
Andere Namen	SI1058X-T1-E3DKR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	380pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	5.9nC @ 5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 20V 236mW (Ta) Surface Mount SC-89-6
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	-

SI1058X-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI1058X-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI1058X-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI1058X-T1-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI1054X-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 12V 1.32A SC89-6</p>	 <p>SI1056X-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V 1.32A SOT563F</p>	 <p>SI1058X-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V 1.3A SOT563F</p>	 <p>SI1060-A-GMR Silicon Labs IC RF TXRX+MCU ISM<1GHZ 36-WFQFN</p>
 <p>SI1058X-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V SC89</p>	 <p>SI1056X-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 1.32A SOT563F</p>	 <p>SI1056X-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V SC-89-6</p>	 <p>SI1060-A-GM Silicon Labs IC RF TXRX+MCU ISM<1GHZ 36-WFQFN</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI1058X-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI1058X-T1-E3 Datenblatt	SI1058X-T1-E3-Datenblätter	SI1058X-T1-E3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI1058X-T1-E3
SI1058X-T1-E3 Electronic	SI1058X-T1-E3-Komponenten	SI1058X-T1-E3-Verteiler	SI1058X-T1-E3-Bild	SI1058X-T1-E3-Teil
SI1058X-T1-E3 Preis	SI1058X-T1-E3 Hersteller	SI1058X-T1-E3 Bild	SI1058X-T1-E3 Aktie	SI1058X-T1-E3 Inventar
SI1058X-T1-E3 Neu	SI1058X-T1-E3 Original	SI1058X-T1-E3 garantiert	SI1058X-T1-E3 RFQ	SI1058X-T1-E3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited